

МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА $Hg_{1-x}Eu_xTe$ и $Hg_{1-x}Eu_xSe$

Крылов К. Р., Пономарев А. И., Цидильковский И. М.,
Гавалешко Н. П., Хомяк В. В.

На образцах $Hg_{1-x}Eu_xTe$ ($0 < x < 0.07$) и $Hg_{1-x}Eu_xSe$ ($0 < x < 0.01$) в интервале $T = 1.7 \div 300$ К измерены магнитная восприимчивость (χ), сопротивление и эффект Холла. При $T > 80$ для $Hg_{1-x}Eu_xTe$ и $T > 10$ К для $Hg_{1-x}Eu_xSe$ $\chi(T)$ описывается законом Кюри—Вейсса, что позволило определить концентрацию ионов европия и знак обменного взаимодействия между ними.

В интервале $200 \div 300$ К в образцах $Hg_{1-x}Eu_xTe$ достигается область собственной проводимости. Определены эффективные массы электронов m_e и величина щели $e_g = e_{\Gamma_0} - e_{\Gamma_1}$.

Для образцов $HgEuSe$ определены концентрации электронов и их эффективные массы. Уменьшение холловской подвижности (в 3—5 раз) по сравнению с $HgSe$ обусловлено, по-видимому, дополнительным рассеянием на атомах Eu.

К числу наиболее изученных полумагнитных полупроводников (ПМП) относятся соединения типа $A^{II}B^{VI}$ с растворенной в них примесью Mn. Значительно меньше изучены ПМП с другими примесями d -элементов, и нам вовсе не известны работы, в которых изучались бы физические свойства соединений $A^{II}B^{VI}$ с растворенными в них f -элементами. В работах [1, 2] сообщалось о синтезировании твердых растворов $Hg_{1-x}Eu_xTe$ и $Hg_{1-x}Eu_xSe$, и мы уже докладывали о результатах исследований некоторых свойств этих соединений [1—4].

Здесь мы приведем результаты исследования магнитной восприимчивости, сопротивления и эффекта Холла на 10 образцах $Hg_{1-x}Eu_xTe$ с $0 \leq x \leq 0.07$ и на 5 образцах $Hg_{1-x}Eu_xSe$ с $0 \leq x \leq 0.01$ в интервале температур $1.6 \div 300$ К. Измерения магнитной восприимчивости проводились индукционным методом и методом Фарадея в магнитных полях до 12 кЭ, сопротивление и эффект Холла измерялись в постоянных полях до 60 кЭ и в импульсных магнитных полях до 300 кЭ.

1. $Hg_{1-x}Eu_xTe$. На рис. 1 приведены температурные зависимости обратной восприимчивости ионов европия.

Из рис. 1 видно, что в области температур $T > 80$ К для всех образцов магнитная восприимчивость описывается законом Кюри—Вейсса.

С помощью найденных из эксперимента значений постоянных Кюри мы определили концентрацию магнитных ионов европия x , полагая диамагнитную

Экспериментальные параметры образцов ПМП

ПМП	T , К	χ_{Eu} , %	$n \cdot 10^{-16}$, cm^{-3}	$R_s \cdot 10^{-3}$, $cm^2/B \cdot c$	Θ , К	$\frac{m_e}{m_0}$	E_g , мэВ
$HgTe$	77	—	5.7	69	—	0.030	300
$Hg_{1-x}Eu_xTe$	77	3.7	5.6	17	—	0.026	260
		4.5	6.2	50	—4	0.028	280
$HgSe$	4.2	—	0.74	60	—	0.040	—
$Hg_{1-x}Eu_xSe$	4.2	0.046	110	28	4.5	0.051	—
		0.053	70	11	5.0	0.039	—

восприимчивость матрицы $\chi_0 = -0.345 \cdot 10^{-6}$ см³/г [5] и пренебрегая парамагнитной восприимчивостью свободных электронов. Для всех исследованных образцов $\theta < 0$, что свидетельствует об антиферромагнитном (АФ) обменном взаимодействии между ионами европия. Нам не удалось выявить зависимость $\Theta(x)$, хотя для разных образцов значения Θ лежат в интервале $-(4 \div 30)$ К (см. таблицу).

При низких температурах ($T < 70 \div 80$ К) у зависимостей $\chi_{\text{Eu}}^{-1}(T)$ увеличивается наклон (рис. 1), но значения характеристической температуры Θ остаются отрицательными и равными $-(5 \div 6)$ К, т. е. практически совпадают

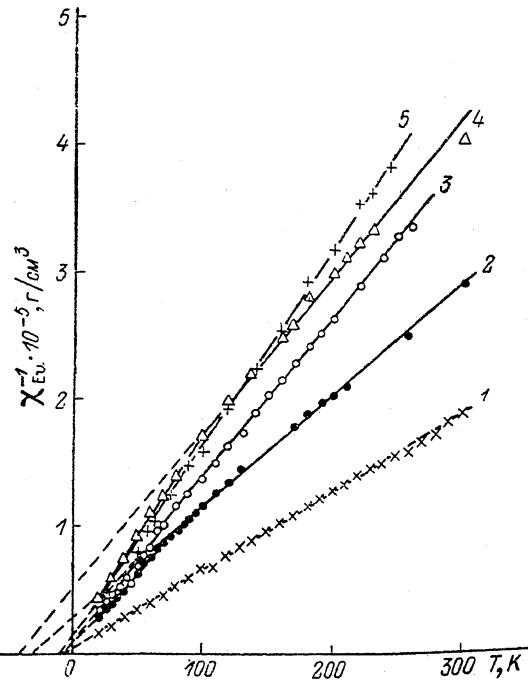


Рис. 1. Температурная зависимость χ_{Eu} образцов $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Te}$ с различным содержанием Еу.
 $x: 1 - 0.072, 2 - 0.046, 3 - 0.032, 4 - 0.037, 5 - 0.027.$

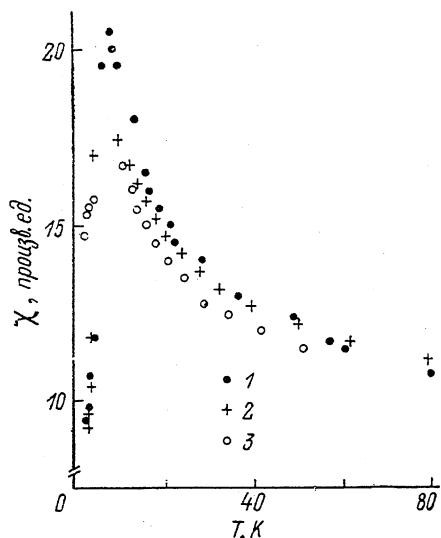


Рис. 2. Динамическая восприимчивость образца 2 в постоянном внешнем магнитном поле.
 $H, \text{ Гц}: 1 - 0, 2 - 300, 3 - 500.$

со значением Θ для EuTe [6]. Это наводит на мысль, что образцы являются двухфазными: одна фаза — твердый раствор $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Te}$, другая — EuTe. Микрорентгеновский анализ, проведенный на установке «Самевах», подтвердил это предположение: в образцах были обнаружены микровключения фазы EuTe, хотя обычные лауреграммы не выявили двухфазности.

Установить соотношения между концентрациями европия, входящего в каждую из этих фаз, нам не удалось.

На образцах с наибольшей концентрацией Еу были выполнены измерения динамической магнитной восприимчивости в зависимости от температуры. Амплитуда переменного магнитного поля составляла ~ 10 Гц, а частота ~ 100 Гц. Для выявления влияния магнитного поля на магнитную восприимчивость мы прикладывали дополнительное стационарное магнитное поле до 1 кЭ. На рис. 2 приведена зависимость $\chi(T)$ для одного из исследованных образцов. Видно, что при $T \approx 10$ К имеется острый пик, который уменьшается и размывается с ростом магнитного поля, что характерно для спиновых стекол [7].

Из измерений эффекта Холла в импульсном магнитном поле мы установили, что все исследованные образцы *p*-типа, хотя в слабых полях основными носителями являются электроны. Разность концентраций акцепторов и доноров $N_A - N_D$ определить не удалось, так как при 77 К в магнитном поле до 300 кЭ коэффициент Холла $R > 0$ и не достигает насыщения.

В интервале 200–300 К для некоторых образцов зависимость концентрации электронов от температуры $n(T)$ подчиняется закону $n \sim T^{3/2}$. По формуле, справедливой для бесщелевых полупроводников, $n = 2 m_e m_b^{1/2} (2 k_B T / 2\pi\hbar)^{3/2}$ [8], мы определили для этих образцов эффективные массы электронов m_e , полагая массу дырок $m_b = 0.4 m_0$, где m_0 — масса свободного электрона. Используя выражение

$$\frac{m_0}{m_e} = \frac{2}{3} \frac{\epsilon_p}{\epsilon_g} - (\delta\gamma_1 - \delta\gamma_2)$$

и полагая $\delta\gamma_1 = 5.2$, $\delta\gamma_2 = 1.4$ [9], а $\epsilon_p = 18.2$ эВ [10], мы определили величину щели $\epsilon_g = \epsilon_{\Gamma_6} - \epsilon_{\Gamma_8}$ для образцов, в которых достигается область собственной

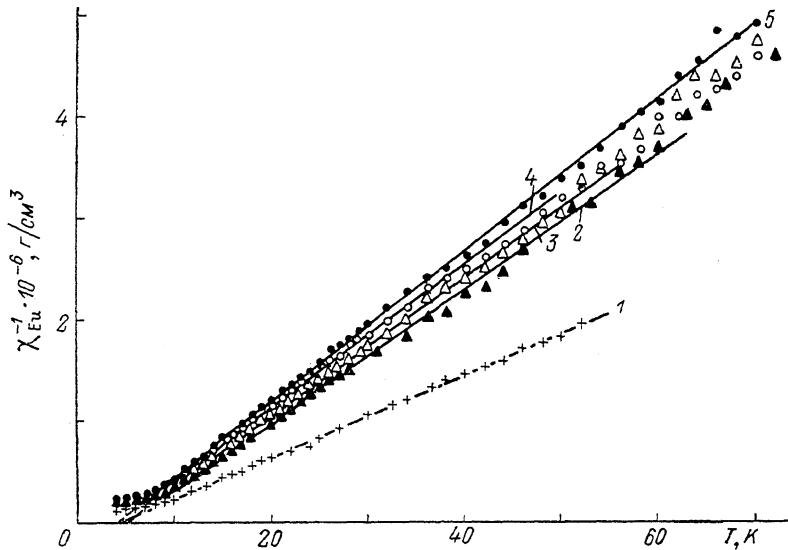


Рис. 3. Температурная зависимость χ_{Eu} образцов $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Se}$.
 $x \cdot 10^4$: 1 — 8.6, 2 — 5.3, 3 — 5.1, 4 — 4.8, 5 — 4.6.

проводимости (см. таблицу). Полученные значения ϵ_g оказались меньше, чем в HgTe , что указывает на существование фазы твердого раствора $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Te}$ в исследованных образцах.

2. $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Se}$. На рис. 3 приведены температурные зависимости обратной восприимчивости ионов Eu^{2+} для 5 образцов $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Se}$, полученные в магнитном поле $H = 12$ кЭ. Видно, что в области температур выше 10 К магнитная восприимчивость описывается законом Кюри—Вейссса. Используя эти данные, мы определили содержание ионов Eu^{2+} в исследованных образцах, которое отличается от вносимого в сплав на 1–2 порядка.

Для всех исследованных образцов парамагнитная температура $\Theta > 0$, что свидетельствует о преобладании положительного обменного взаимодействия между ионами Eu^{2+} .

При $T < 10$ К зависимость $\chi_{\text{Eu}}^{-1}(T)$ отклоняется от линейной и стремится к насыщению при низких температурах. Значения величин Θ , определенные для образцов с разными x , мало отличаются друг от друга. Возможной причиной отсутствия зависимости $\Theta(x)$ может быть выпадение фазы EuSe при выращивании твердого раствора $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Se}$. Температура Кюри $\Theta_{\text{EuSe}} = 6$ К [6], и хотя рентгеновский анализ указывает на монокристалличность образцов, нельзя исключить возможность существования фазы EuSe , которая, очевидно, не проявляется из-за малой концентрации европия в образцах.

В бесщелевых полупроводниках, где вырождение зон обусловлено симметрией, обменное взаимодействие между магнитными ионами, находящимися в узлах кристаллической решетки, должно быть отрицательным [11]. Мы считаем,

что положительный знак Θ в исследованных нами образцах обусловлен наличием в них фазы EuSe.

На зависимости сопротивления одного из образцов от температуры ($H=0$) при 4.5 К обнаружен резкий скачок сопротивления (рис. 4). В магнитном поле ступенька уменьшается и исчезает при $H_c \approx 10$ кЭ. Коэффициент Холла в этом интервале температур не изменяется, поэтому скачок сопротивления, возможно, связан с резким изменением рассеяния при 4.5 К. Можно предположить, что при низких температурах благодаря обменному взаимодействию между ионами Eu^{2+} (через электроны проводимости или анионы Se) происходит упорядочение их магнитных моментов, которое разрушается при $T \approx 4.5$ К. Это, в свою очередь, приводит к резкому включению дополнительного механизма рассеяния электронов на магнитных моментах Eu^{2+} . В магнитном поле $H < H_c$ антиферромагнитное упорядочение частично разрушается и ступенька сопротивления на зависимости ρ (T), обусловленная изменением рассеяния, уменьшается.

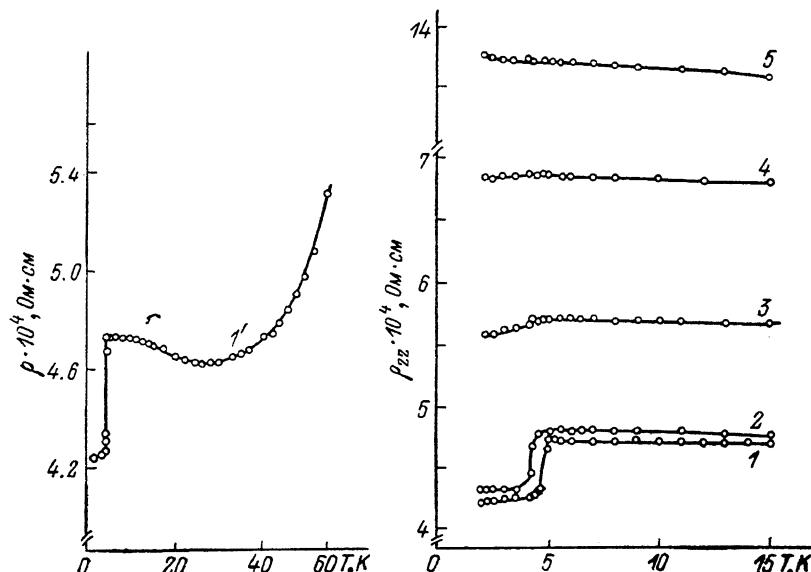


Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления образца 1 $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Se}$ в фиксированных магнитных полях.

H , кЭ: 1, 1' — 0, 2 — 1, 3 — 5, 4 — 10, 5 — 50.

Мы измерили также продольное и поперечное сопротивления в постоянных магнитных полях до 60 кЭ в интервале 1.7–20 К. На зависимостях сопротивления от магнитного поля проявляется более 20 пиков осцилляций Шубникова—де-Гааза. По осцилляционной зависимости сопротивления от магнитного поля и температуры определены концентрация электронов и их эффективная масса (см. таблицу).

Холловская подвижность для исследованных образцов оказалась в 3–5 раз меньше, чем подвижность электронов в HgSe с такой же концентрацией примесей. Это различие, по-видимому, обусловлено тем, что атомы Eu служат дополнительными центрами рассеяния электронов. Вместе с тем совпадение эффективных масс электронов в образцах $\text{Hg}_{1-x}\text{Eu}_x\text{Se}$ и HgSe с почти одинаковой концентрацией носителей указывает на то, что атомы Eu в исследованных образцах практически не вносят искажений в энергетический спектр.

Авторы выражают благодарность Л. Н. Ромашову за предоставление установки для измерения динамической магнитной восприимчивости, М. И. Ауслендеру и Н. Г. Шелушининой за полезные обсуждения.

Л и т е р а т у р а

- [1] Гавалешко Н. П., Кавьюк П. В., Лотоцкий В. Б., Солончук Л. С., Хомяк В. В. // Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1985. Т. 21. В. 11. С. 1965–1966.

- [2] Гавалешко Н. П., Хомяк В. В., Солончук Л. С., Криган В. А. // Тез. докл. IV Всес. конф. по физике и химии редкоземельных полупроводников. Новосибирск, 1987. С. 97.
- [3] Крылов К. Р., Пономарев А. И., Цидильковский И. М., Хомяк В. В. // Тез. докл. II Всес. конф. «Материаловедение халькогенидов и кислородсодержащих полупроводников». Черновцы, 1986. Т. 2. С. 57.
- [4] Krylov K. R., Ponomarev A. I., Tsidilkovski I. M., Gavaleshko N. P., Homiak V. V. // Int. Meeting on Phys. of Semimagn. Semiconductors. Jablonna, Poland, 1987. P. 47—48.
- [5] Иванов-Омский В. И., Коломиец Б. Т., Мельников В. М., Огородников В. К. // ФТТ. 1969. Т. 11. В. 2. С. 2563—2567.
- [6] Van Honten S. // Phys. Lett. 1962. V. 2. N 5. P. 215—216.
- [7] Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества. М., 1983. 304 с.
- [8] Tsidilkovski I. M., Harus G. I., Shelushinina N. G. // Adv. Phys. 1985. V. 34. N 1. P. 43—174.
- [9] Kim R. S., Narita S. // Phys. St. Sol. (b). 1976. V. 73. N 2. P. 741—752.
- [10] Dobrowolska M., Myscielski A., Dobrowolski W. // Sol. St. Commun. 1978. V. 27. P. 1333—1335.
- [11] Bastard G., Lewiner C. // Phys. Rev. B. 1979. V. 20. N 10. P. 4256—4267.

Институт физики металлов
УНЦ АН СССР
Свердловск

Получена 3.05.1988
Принята к печати 9.09.1988